한국특허공보 특1995-8844호 1부.

[첨부그림 1]

基1995-0008844

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 특허공보(B1)

(45) 공고일자 1995년00월08월 (51) Int. CI. (11) 공고번호 특1995-0008844 HD1L 21/02 (21) 출원번호 **5** 1991-0015384 (65) 공개번호 E 1992-0007081 1991년09월03일 (43) 공개일자 2-234095 1990년09월03일 일본(JP) 1992년04월 28일 (22) 출원일자 (30) 우선권주장 다이닛뿅스크린 세이조오 가부시키가이샤 이시다 아키라 (71) 출원인 양본국 교오토후 교오토시 가미코오구 호리카와 도오러 테라노무치 아가루 4표오메 덴장기타마치 1반치노 1 (72) 발명자 디서다 마셔미 일본국 교오토후 교오토사 후시마구 하조기시 후루카와 표오 322반치 다이닛 롱스크린 세이조오 가부시키기이사 라구시에 고오죠오 내 회모토 마사하로 일본국 교호토후 교호토시 후시마구 하즈가시 후투카와 표오 322반차 다이닛 중소크린 세미조오 가부시키기이샤 라구시아 교호조오 내 하다다 단초야 일본국 교오토후 교오토시 후시마구 하즈가시 후루카와 표오 322반치 다이닛 콩스크린 세미조오 가부시키기이사 라구시아 고오죠오 내 151015로 포토요 일본국 교오토후 교오토시 후시마구 하즈가시 후쿠카와 표오 32번차 다이닛 총스크린 세미조오 가부시키기에서 라구시에 고오죠오 내 오카모토 디캐오 알본국 교오토후 교오토시 후시마구 하즈카시 후루카와 표오 322반차 다이닝. 랭스크린 세미조오 가부시키기이사 라구시이 교오죠오 내 임석자, 김용복 (74) 대김연 丛小者: 艺会至(年以书生 及400位) (54) 반도체 처리시스템에 있어서 반도체 기관을 반송하는 병법 및 장치

200

내용 없읍,

445

£1

BAN

(발명의 명칭)

반도체 처리시스템에 있대서 반도체 기판을 반승하는 방법 및 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 실시에에 따른 반도체 기관처리용 시스템을 나타내는 투시도

제2도는 제1도에 나타낸 시스템을 나타내는 블럭도면.

제3(c)는 제에 나타난 시스템에서 채용된 기관합 반승하는 무우트를 나타내는 모식적 공연도,

제3(b)는 제3(a)도에 나타난 무우트를 나타내는 블럭도.

저4도는 중래 반숨 방법으로 처리되는 기관의 클로워를 나타낸다.

제5도는 반송 시간을 설명하는 설명도.

제6도는 십시대에 따른 로보트(5)의 이동을 설명한다.

제7도는 심시에에 관한 기관반승 방법의 전체 호롱을 나타내는 프로워 차트:

제8도는 내지 제기도는 실시에에 관한 기관을 받승 방법의 일부분의 호흡을 나타내는 클로워 차트.

馬1995-0008844

제124도 및 제125도는 실시에에 따라서 처리된 웨이퍼의 호흥을 나타낸다.

제134도는 반도체 기관용 가열처리기의 개념을 나타내는 모식적 평면도.

제136도는 반송 웨이퍼에 대한 처리 순서를 나타낸 도면.

제14도는 중래 기술의 하나의 예를 나타내는 단면도.

제15(a)도와 제15(b)도는 기열처리에서 온도 커브를 설명한다.

◆ 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

3: 知01世

41,42 : 기열처리부

43,44 : 냉각처리부

5 : 로보트

18a, 18b, 18c, 18d : 투입대기시간

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 반도체 처리시스템에서 반도체 기관을 반승하기 위한 장치와 방법에 관한 것으로 특히, 기렴처 리부를 포함하는 복수의 기관 처리부에 대하여 반송수단이 소정의 순서로 각 처리부를 순환이동하여 복수 의 반도체 기관을 순차적으로 반승하는 기관의 반승장치 및 방법에 괜한 것이다.

반도체 기판에 대한 가열처리는 반도체 장치의 저조에 극히 중요하다. 메달들면, 포토리소그래픽 기술에 있어서, 소망의 구조로 회로의 미단을 만드는 것은 물론 반도체 내로 불순물을 확산시키기 위해 가열처리 가 필요하며, 포터레지스터에 대한 가열처리는 때단의 정도(程度)에 큰 영향을 준다.

많은 수의 기판에 대해 고호율로 가열 처리를 실행하기 위해서 다양한 종류의 장치가 실시되어 왔다.

제134도는 반도체 기관용 가열처리장치의 개념을 나타내는 평면도이다.

예용들면, 설리콘 웨이퍼(3)와 같은 반도체 기관을 저장하는 카셰트(2)가 인덱시(1)상에 탑재되어 있다. 미용기구(8)과 로보트(5)는 스테이저(6)상에 탑재되어 있다. 로보트(5)는 제1암(71)과 제1암(71) 이래에 감착하게 제13도에 나타나지 않는 제2암(72)을 구비하고 있다. 스테이저(6)을 가로끌려 인덱시(1)의 반 마속에서는 가열처리부(4),42)와 남작처리부(43,44)가 기열처리부 (41,42)이래에 숨겨져 있으므로, 제13도에 나타나지 않는다.

기열처리부의 동작은 이래와 같다.

이용가구(0)는 로보트(5)가 스테이지 (6)상에서 운행하도록 화상표(R,0)로 나타난 바와 같아, 로보트(5)를 각각 이용하여 회전시킨다.

암(?1,72)이 로보트(5)로 부터 거리가 떨어진 장소로 부터 기관을 넣고 빼낼 수 있도록 암(?1,72)은 출처 지고 당겨진다.

제외 변승하기 위한 로보트(5)의 이러한 동작을 통해서, 커서트(2)내에 저장되는 각 웨이퍼(3)는 커서트(2)로 부터 한개한게 집이내어 가염처리부(41), 남작처리부(43), 가염처리부(42) 및 남작처리부(42) 및 남작처리부(43)로 소보로 다 개인퍼(3)의 각각은 더 처리부대의 소장의 가염처리 또는 남각처리를 받은 후에 위비표 가세트(2)에 다시 저장된다. 많은 수의 위이퍼상에서 좋은 사건비에 일관의 엄처리를 수행하는 목적으로, 해내의 처리부로 부터 하나의 웨이퍼를 거내는 과정은 그 처리부로 웨이퍼를 집에넣는 과정에 연관하여 수행되는 소차적인 방법으로 반송된다. 예출들만, 가염처리부터에 에서 가입처리를 받은 하나의 위이퍼가 방작처리부(43)로 반송됨에, 다음으로 처리되어의 또 다른 웨이퍼가 가염처리부(41)로 투입된다. 따라서, 각 웨이퍼는 처리부(41)에서 처리부(44)까지의 순서로 각 처리를 순차적으로 받게 된다. 다른 관점으로 보면, 처리부(4~44)는 그 안에 수용된 웨이퍼상에서 등시에 각 처리를 수행한다. 제 13도는 재점적으로 상기처리와 반송의 호통을 나타낸 것이다. 로보트(5)는 반송과정(F,)에서 반송과정(F,)까지의 순서로 반송을 계속 반복한다.

처리부(41)~처리부(44)에서의 각 가열 및 생각처리를 완료하는데 요구되는 시간은, 예술 줄면, 표 때 나타난 바와 같이, 결정된다.

(H. 1)

로보트(5)가 하나의 처리부에서 다음 처리부로 이동하여 엮이퍼를 꺼내고 또 다른 엮이퍼(3)를 넣는데 8. 초가 걸린다. 인덕서(1)는 상기 처리부의 하나로 간주된다.

웨이퍼(3)의 호름이 모든 처리부(41,42,43,44)품 통하며 호르는 정상상태에서는, 처리부(41,42,43,44)품 따라서 웨이퍼(3)를 반송하기 위한 로보트(5)의 순환속도는 기업처리부(42)에서의 가영 처리시간에 따라 저한된다. 이것은 기업처리부(42)에서의 가업처리가 각 처리시간 중 70초안 기장 긴 처리시간읍.요구하기 때문이다. 애롭들면, 웨이퍼를 빠져하는 로보트(5)가 처리부(42)로 도달하는 시험을 가장하면, 이 시험에 서, 이전의 웨이퍼에 대한 처리부(42)에서의 처리가 완료되지 않으면, 가염처리부(42)안으로 새로운 웨이 퍼를 투입하기 위해 이전 웨이퍼를 꺼내는 것이 불가능하다. 따라서 이전의 웨이퍼ው 대한 가염처리부 (42)에서의 '제소의 처리가 완료되는 시간동안 대가하여야 하며, 로보트(5)는 그 다음의 반송과정 (F.,F.,F.,F.,F.,F)에 들어 갈 수 없다. 그러므로 로보트(5)에 의한 가염처리부(42)내에서 웨이퍼의 교환과 반송단계(F.)는 먼저 번의 반송단계(F.)가 시작한 시청에서 적어도 '제소가 지난후에만 시작할 수 있을 뿐 미다. 즉, 로보트(5)의 반송 무트는 적어도 '제소가 렇린다. 예를 뚫면, 80소의 처리시간을 요구하는 가영 처리부(41)에 대해서도, 로보트(5)가 마지막으로 떠나서 되렴마를 때까지 적어도 '제소가 지나간다. 로보 토(5)와 반송 등작에 요구되는 시간은 8초 × 5~40초이므로 이 등작은 처리경로의 순회속도를 제한하는 요 소는 아니다. 따라서, 웨이퍼의 흐름이 모든 처리부(41,42,43,44)를 중하여 흐르는 등안 하나의 처리부 대의 웨이퍼(3)는 항상 '위용처리부(42)내의 '가염처리의 종료에 요구되는 적어도 '제소의 시간'적으로 다 음 처리부로 반송된다. 그러므로, 처리부(41~44)에서 각 처리에 요구되는 원래의 '처리시간에 구매없이 약 '제소 동안 웨이퍼(3)는 각 처리부(41~44)내에 머롭게 된다.

포토레지스트에 대한 처리에 있어서, 냉각처리부(43,44)에서 각 처리시간이 70초로 지연되는 것은 거의아 무런 문제를 일으키지 않는다. 그러나, 어떤 경우에 있어서, 가접처리부(41)에서 처리시간의 지연은 포토 레지스트에 해로운 영향을 끼친다. 특히, 포토레지스트에 대한 패턴 정말도는 과일에 의해 저하하게 된다.

으는 특허 공고 평 1-49010(1989)에는 상기의 문제점을 해결하기 위한 기술이 개시되어 있다. 이 기술은 제4(a)와 제14(b)에 도시하여 간단해 설명해된다. 기업처리부에서, 웨이퍼(3)물 지지하는 승강지지대(10)와 생각 에어노룹(11)이 핫 클램이트 위에 설치되어 있다. 웨이퍼(3)는 제14(a)도에 나타난대로 가업처리가 그 위에서 설립되는 동안에 핫 클램이트에 접촉되어 있게 된다. 가업처리가 소청의 처리시간동안 실행된 후, 웨이퍼(3)는 승강지지대(10)에 의해 위로 등마흡격자서 동시에 핫클레이트(9)로 부터 분리되고, 제14(b)도에 나타난 바와 같이, 병각에어가 발각에머 노플(11)을 통해서 웨이퍼(3)에 분산되어서 웨이퍼(3)를 발각하게 된다.

그러나, 이 기술은 전체 가염처리부의 경비가 크게 증가해 버린다. 더욱이 핫클레이트(9) 자체의 온도분 또는 냉각에(1도움(11)가 주위가 과생되므로서 군일하게 되지 않는다. 그 경과, 워이퍼(3) 상의 온도 분 포가 고암하지 않게된다. 물균임한 온도 분포를 피하기 위해, 웨이퍼(3)는 공기를 뿜어내지 않은해 승강 지지대(10)에 의해 핫 클레이트(9)로 부터 분리를 수 있다. 상기 개술은 머느 정도의 온도로 과명을 감소 사키나, 포토레지스트상에 나타배는 해로운 결과는 방지할 수 있다.

지기다. 도도대시으트에 다른데는 에로운 발생을 설망한다. 제15(a)도는 가열처리부(41)에서의 이상 의에 대하여 제15(a) 및 15(b)를 참조하여 본 방생을 설망한다. 제15(a)도는 가열처리부(41)에서의 이상 적인 온도곡선을 실망하는 도면이며, 60초등안 100°C의 온도에서 가열처리가 삼행되어야 하는 것을 나타 낸다. 한편, 제15도(b)도는 웨이퍼(3)가 처리를 통하여 그 순서로 이동할 때 가열처리부(41)내의 실질적 인 온도 곡선을 설망하는 도면이다. 웨이퍼(3)가, 60호가, 지난 후 핫 들레이트로 부터 본리된다고 하도 제 15(b)도의 빗금찬 부분에 대하여 표시된 과열부가 위치에(기)가 제2가하게 된다. 그러므로, 가열처리부(1)내의 요구되는 가열처리가 중로된 후 핫 플레이트(9)로 부터 웨이퍼(3)를 본리하는 것만으로는 이상적 던 온도곡선에 유시한 설계의 온도곡선을 얻기가 어렵다.

공부수의 웨어퍼로트가 순차로 처리되고, 그를 각자의 처리시간이 서로 다르게 될때, 또 다른 운제정이 생 긴다. 이를 웨어퍼로트에 포함한 웨어퍼가 순차적으로 처리될때, 같은 로트의 웨어퍼 중에서 과잉염의 당이 변통한다. 제1로트내의 웨어퍼가 표 1에 따라서 다른 처리부(4).43,44)에서 처리되고, 한편 제2로트 의 웨어퍼가 6초등안 처리부(42)내에서 처리되는 조건이래서 순차로 제1 및 제2로트가 처리되는 경우의 에가 주어져 있다. 그러한 경우에 있어서, 제1로트의 최종의 웨어퍼에 에어서 제2로트의 앤 먼저의 웨어 퍼가 처리공정으로 들어갈때...가장 긴처리시간은 제소에서 65로 바뀐다. 따라서 가열처리부(4)에서의 과임시간은 10초에서 5초로 바뀐다. 그러는 3 제2로트에서 웨어퍼테에서 어떤 웨어퍼는 10초 등안 고입 처리금 받고, 어떤 것은 5초 등안 가입처리를 받는다. 그 결과, 포토리지스트의 노출 및 현상에 있어서 한지 및 노출량과 같은 중요한 제어파라메터가 웨어퍼머다 다르게 된다.

'한계 광 '노출량'이란 광에 노출된 광 감광물질이 대한 현상 조건하게 완전하게 분해할 수 있는 광노출 당을 의미한다.

상으면 문제점은 처리시간이 다른 목수의 로트가 순처로 처리되는 경우에 하나의 로트에서 단음 로트로의 일현처리의 과도기간에만 한정되는 것은 아니다. 일반적으로, 이를 문제점은 다음과 같은 과도기간에 한 저하게 나타난다. 즉, 상기 문제점은 하나의 로트의 처리가 사작되어 영상생태에는 이로지 않는 청소의 기간과 그리고, 하나의 로트바의 청중 웨이퍼가 처리경로에 돌아가서 청중 웨이퍼의 각 처리가 완료되지 않은 청중기간에 한저하게 나타낸다.

본 발명은 반도체 기관에 소쟁의 처리를 하기 위해 제1~제4의 처리부를 가진 시스템에서 변승수단으로 반도체 기관을 순치적으로 반승하는 방법에 지합되어 있다.

제1~제에의 처리부는 반도체 기관에 가입하기 위한 적어도 한제의 가입처리부를 가지고 있으며, 반도체 가관은 제1~제체처리부를 순관하는 처리경로를 따라서 반송되며, 여기서 N은 1보다 큰 청수이다.

본 발명에 따르면 상기 방법은 (a) 제1~제1의 처리부에 공통인 먹트시간 [과, 호기 1호] 처럼 만즉시키는 수라 할 때 대기시간 [,]를 포함하는 파라미터 값을 결정하는 수렵과; (b) 반송수단이 처리경로를 따라 반복순환하고 반도체 기관의 호류이 제1~제1처리부로 반도체 기관을 순차로 반송하는 스템을 포함한다.

반도체 기관성의 과열을 피하기 위해서. (j-건), (j-1) 및 (j)번째의 처리부로 부터 보내온 반도체 기관 (S-),(S),(S)-)이, (j-1),(j-1)번째 처리부에 각각 존재하게 되는 상태가 얼어지게 된다.

그때, (j-1)번째 처리부로 부터의 반도체 기관(S,-1)은 반송수단에 의해 1번째 처리부로 반송된다. 반송수 단은 1번째 처리부로 부터 반도체 기관(S,-1)을 꺼낸 이후 럭트시간(To)이 경과할 때까지 1번째 처리부 앞 에서 대기한다.

반송수단은 핵트시간(To)이 지나면, J번째 처리부로 부터 반도체 기관(S,)을 꺼내고, 다시 대기시간 T,등 안 대기한다.

그후, 반송수단은 대기시간 T.i이 경과할 때, J번째 처리부로 반도체 기관(S.-1)를 집어 넣고, 반도체 기관(S.)를 (j+1)번째 처리부로 반송한다.

이를 스텝은 j=1,2···. KM 대하여 반복한다.

단, jel 및 2에 대하여 (j-2)번째 처리부와 jel에 대하여 (j-1)번째 처리부와 jel에 대하여 (j+1)번째 처리부는 반도체 기관을 처리경로로 용급하고 처리된 반도체 기관을 받기 위한 스테이션을 나타낸다.

비람작하기로는 대기시간이 가열처리부에선만 설정하게 하는 것이다.

본 발명에 따르면 일련의 처리가 목수개의 반도체 기관상에서 행하며질 때에도 과의 업처리에 의하여 열 이력의 변동이 방지할 수 있도록 대기시간이 가업처리부 앞에 설정된다. 또한 과도기간에 있어서도 동일 하게 적용되는 맥트시간이 설정된다. 맥트시간은 반송수단이 처리부를 일순하는데 공합하는 대기시간의 함계와 반송수단이 처리부럼 일순하는데 요하는 광단시간과의 할 미상으로 하며, 또 대기시간이 설정된 가업처리부에 있어서는 그 대기산을 포함한 처리부에 있어서의 처리시간 미상으로 하며, 또 대기시간을 설정하지 않는 처리부의 각각에 있어서는 처리시간 미상으로 한 것이다.

함하게 않는 시리구의 역약에 있어서는 지리시간 마음으로 한 것이다. 액트시간에 대하여 요구되는 다른 조건이 있을 수 있다. 액트시간은 설정된 대기시간 및 일순이동시간의 합보다 걸대, 동시에 대기시간이 설정되면 있지 않는 경우에는 각 처리부의 어느것 보다도 같다. 미를 조 건축 만역시키게 택트시간이 결정되면 처리부가 대기시간이 설정되어 있는가 엄쳐리부인지 아니면 대기시 같이 설정되어 있지 아니한 처리부인지에 관계 없어, 반송수단이 최종으로 거기를 떠난 후 각 처리부를 많순한 후 다시 거기로 뚫아볼 때에 각 처리부에서의 처리가 알로된다. 특히 대기시간이 설정되어 있는 가열처리부에서는 처리의 중로시간이 반송수단이 모든처리부를 일순하고 부가한는 시간과 알겠단다. 그러 므로 반도된 기관은 기열처리가 완료된 후 즉시 기업처리부를 부터 반송된다. 미렇게 검정된 택트시간을 근거하여 반송수단은 웨이퍼를 반송하므로, 반도체 기관으로 부터 다른 조(set)의 반도체 기관으로 처리 가 수행하는 과도기의 기간에 조차도 한 조의 반도체 기관으로 부터 다른 조(set)의 반도체 기관으로 처리 다.

가열처리부의 처리시간과 먹트시간과의 차이 부분이 가열처리부의 앞에서 반송수단의 대기시간으로 사용 된다. 그러므로 먹트시간 공통의 전체처리를 통하며 결정될때, 가염처리의 열이먹은 아무런 영향도 받지 않는다.

본 발명에 있어서, '순환'혹은 '순환하다'라는 용어는 반송수단이 처리경로를 따라서 움직이어서 다시 원 래의 위치로 되돌아가는 것을 나타내기 위해 사용된다. 그리고 순환은 부우프 이동아거나 혹은 왕복 이동 임 수 있다.

'반송시간'은 처리경로를 따라서 반송수단이 일순하는 시간이고 처리부에서 처리시간은 포함되지 않는다.

'먹트시간'은 하나의 처리부에서 반송수단이 동작을 시작하며 반송수단이 임순한 후, 이어 같은 처리부에서 다시 같은 동작을 시작할 때까지 걸리는 시간에 해당한다.

따라서 본 방망의 목적은 과잉의 열차리를 최피하여 소앙의 가열처리시간에만 가열처리를 향하고, 일현의 워마퍼를 처리할 때의 과도기간에 있어서도 제대 미리미터의 편차가 상기시 않는 기관변송방법을 제공하 는 데 있다.

본 발명의 전출한 이외의 목적, 특징, 형태와 첫참출 첨부도면과 관련하여 현해지는 본 발명의 다음의 상 생한 설명으로 부터 다음 명확하진다.

제1도는 본 발명의 실시에에 관한 처리 반도체(기관에 대한 지스템(100)을 나타내는 사시도이다.

제1%도에 나타난 가염 처리장치와 동양으로, 시스템(100)은 냉각처리부(43,44)는 물론 가염처리부 (41,42)를 구내한다. 웨이퍼(3)가 보관되는 가세트(2)는 인역사(1) 위에 배치된다. 기관 반송 로보트(5)는 상위스테이지 및 하위스테이지인 2개의 스테이지내 각각 설치된 아암(71,72)를 구내하고 있고, 스테이지(6)에 각각 설치된다. 기관 이제로보트(12)는 인택사(1)상에 설치된다.

도포 처리부(13)는 스테이지 (6)을 가로질러 처리부(4) 42,43,44)의 반대쪽에 설치된다. 이 도포 처리부 (13)에서 각 웨이퍼(3)는, 여름물면, 포토레지스트가 웨이퍼성에 형성하도록 도포 처리를 받게 된다. 제2 도근 시스템(100의 클릭도이다. 콘트롤러(15)는 입력, 설정, 보관 및 기관 반송 로보트(5) 및 기관 이제 로보트(12)의 각 처리부에 대한 다양한 데이터의 작동을 제어하도록 동작한다. 키보드(19)와 디스클레미 (14)는 입통력 장치로 각각 체용되어 있다. 더 자세한 것은 후에 기술하나, 키보드(19)로 부터 입력된 데 이터에 의해, 콘트롤러(15)는 로보트(5:12)를 제대하도록 처리를 한다.

'콘트롤러(15)는 CPU, 여러가지의 데이터와 소프트웨어 프로그램을 저장하기 위한 CPU와 메모리와 시스템 (100)의 타이밍제어를 위한 시간을 제어하기 위한 타이때 수단으로 이루어진다.

(10)의 반응 투우트가 모식적으로 제1도, 제3(e)도 및 제3(b)도에서 설명되어 있다. 카센트(2)의 웨이퍼(3)(제3(e)도 함조)가, 처리되기 위해 대가상태에 있으며, 예출들면, 미재로보트(12)를 경유하여 로보트(5)의 암(71)위에 올려지게 된다. 암(72)에 가열처리부(41)에서 처리된 웨이퍼(3e)를 제내도록 로보트(5)는 이동가구(6)의 수단에 의해 가열처리부(41)로 이동한다. 가열처리부(41)는 상기 등작에 의해 비위지게 되고 암(71)이 처리부(41)안으로 웨이퍼(3f)를 집어 넣는다. 가열처리부(41)로 부터 제내지서 암(72)에 파지된 웨이퍼(3ce)는 로보트(5)의 상하승 가구 수단(도시안들)에 의해 방작처리부(43)로 이동한다. 암(71)에 방작처리부(43)로 이동한다. 암(71)에 방작처리부(43)로 이동한다. 암(71)에 방작처리부(43)로 이동한다. 암(71)에 방작처리부(43)로 위하여 있는 사람이 방작처리부(43)로 의용한다. 암(71)에 방작처리부(43)로 부터 이미 처리된 웨이퍼(3d)를 꺼낸 후 암(72)은 처리부(43)만으로 웨이퍼(3e)를 집어 넣는다. 아찬가지로 웨이퍼(3d,3c,3c,3c,3c)는 처리부(43,13,42,44)에서 각각 처리되고, 순차

적으로 카세트(2) 및 처리부(13,42,44)로 각각 이동된다. 로보트(5)의 이동은 화살표(81)에 약해 도시되 어 있다. 처리가 끝난 웨이퍼가 카세트(2)(제3(b)도 참조)로 하나씩 수용되는 동안에 각 처리부에서 새롭 게 처리되어질 웨이퍼가 차례차례로 각 처리부(41,43,13,42,44)로 순차적으로 보내지도록 로보트(5)는 순 완반숭이동을 반복한다.

로보트(5)는 상기 기습된 순환반송 이동물 통해서 웨이퍼(3)를 반송한다. 그러므로 각 웨대퍼는 카세트 (2)에서 떠난 순서로 각 처리부(41,43,13,42,44)로 반송되고, 최후에는 다시 카세트로 되돌아오게 된다.

본 방명의 비담적한 일실시에에 다른 상을된 반송 투우프를 가지는 시스템(100)의 제어호름을 설명하기 전에, 제4도에 도시된 반송 도면을 참조하여 중래의 방법이 웨이퍼만송에 작용할 때, 발생하기 쉬운 문제 정에 대하여 설명한다.

이 설명에 따라 본 발명의 바람직한 실시에에 따른 발명의 특성이 보다 명해하게 될 것이다. 제4도의 좌 측면에 도시된 기호(IND, IP,,CP,,CP,,CP,)는 인력서(I)와, 처리부(41,43,13,42,44)에서 각각 실행하는 처리를 나타낸다. 경로화상표(ISa~IISa)는 해당 웨이퍼상에서 수행되는 처리의 각 호를을 나타낸다. 또한, 상기 화살표는 시간의 호흡을 나타낸다. 즉, 왼쪽에서 오른쪽으로 시간의 경과를 나타낸다. 44전 (17)은 반송 로보트(5)의 이동을 나타낸다. 허물들면, 경로화석표(ISb)는 하기 순서로 처리 IND, IP, CP, 및 CB 이미 받은 웨이퍼(3b)상에서 실행되는 처리의 순서를 나타낸다. 웨이퍼(3b)는 처리를 받은 후 처리부(42)로 부터 꺼내어져서 처리부(44)로 반송된 후 처리 C가 수행되는 처리부(13)로 부터 오는 로보 트(5)에 의해 상기 처리부(44)로 집어 넘어지게 된다.

이어 웨이퍼(3b)가 처리부(44)에서 처리 CP:에 이어서 처리 IND를 받게 된다.

처리 IND는 이재로보트(12)에 약해 형해지는 보관처리이고, 이 처리에 약해 카세트(2)에 웨이퍼(36)가 보 관되게 된다. 이약 마찬가지로, 화삼포(161)는 웨이퍼(31)상에서 형해지는 처리를 나타낸다. 화삼포(16 1)에 나타난 대로, 웨이퍼(31)는 카세트(2)로 부터 페내어지고, 처리 HP, 및 CD, 순서로 처리를 받은 후 처리 C가 수행되는 처리부(13)로 반송된다.

로보트(5)의 반송 동작을 위해 요구되는 반송시간은 그 안으로 다른 웨이퍼를 집어넣는데 필요한 시간은 물론 각 처리부로 부터 웨이퍼를 제대는데 필요한 시간도 포함된다. 제5도는 개념적으로 반송시간을 설명한 것이다. 제5도에서, 기호 우는 각 처리 IND, IPA, CP., C, IPA 및 CP.를 나타낸다. 기호 우나은 PI의다음 처리를, 기호 우나은 PI의 다음 처리를, 기호 우나은 PI의 다음 처리를, 기호 우나은 PI의 대한 처리를 가고 PI의 모든 임(72)에 웨이퍼를 제내는데 요구되는 시간 Tim과 2개의 처리부 사이에서 이동기구(8)가 로보트(5)를 이동하는데 필요한 시간 Teore 및 처리 PI+1가 수행되는 처리부로 부터 다른 웨이퍼를 알(71) 또는 암(72)에 제내는데 필요한 시간 Tout의 합이다.

애플룹면, 처리부(43)에서 처리부(13)로 웨이퍼(36)을 반송하기 위해 필요한 시간은, 처리부(41)에서 수 용되어 있는 웨이퍼(36)를 암(71) 또는 암(72)이 처리부(43)로 집대부는데 요구되는 시간 Thow; 로보트 (5)가 처리부(43)에서 처리부(13)로 이동하는데 요구되는 시간 Twove와, 그리고 처리부(13)에 수용되어 있는 웨이퍼(3C)를 웨이퍼(3C)를 암(71) 또는 암(72)이 꺼내는데 요구되는 시간 Tout의 합이다.

시간 Tin, Teove 및 Tout은 각각 2초, 4초 및 2초이다. 그러므로, 반송시간은 2+42-8초이다. 웨이퍼(3 C)가 처리부(13)로 부터 꺼내어진 후, 웨이퍼(3d)는 암(72) 또는 암(71)에 의해 처리부(13)내에 당아진다.

암(72) 또는 암(71)에 의한 미통작에서 요구되는 시간은 처리부(i3)와 처리부(42)사이의 반송시간내에 포 한되어 있다.

다음의 설명에서 '반송시간'이라는 용어는 하나의 처리부에서 다음 처리부로 웨이퍼를 반송하는데 필요한 시간은 물론 각 처리부에서 반송 웨이퍼를 집에 넣고 퍼질어 내는데 필요한 각 시간을 포함한다.

제3(s)도와 동양으로, 제6도는 웨이퍼의 변승 무트를 모식적으로 설명한 것이다. 각 변승은 동일하게 8초 가 필요하게 된다.

처리 iP,, C, IP, 및 P,에 대한 필요한 처리시간은 각각 60초, 45초, 50초, 70초, 45초이다. 전체 반 승시간은 B초×6-48초이다. 기장 긴 처리시간, 즉 처리 IP,에서의 기초가 일반의 호흡 속도를 결정하는 것 임흡 알 수 있다.

다시 제4도를 참조하면, 로보트(5)가 세션(17)에 의해 나타난 바만 같이, 처리부(41)에 도달할 때, 처리 부(41)에서의 80초의 처리 바다가 이미 완료되었기 때문에 납=10초가 처리부(41)에서 이미 지나가 버리게 되어 있음을 웨이터(31)의 흐름을 나타내는 화살표(161)로 부터 알 수 있다.

그래서 웨이퍼(3*)는 t=10초 등안 파일된다. 이것은 처리 IP, 때문에 기인된 것이다. 화살표(160)에 의해 나타난 바와 같이, 처리 IP,는 ti=70초 등안 웨이퍼(30)상에서 한해장 형용가 있다. 그러므로 처리부(42) 를 함께 로보트(5)가 인텍서(1)를 떠나는 시간은 로보트(5)가 인텍서(1)를 떠난 후 요구되는 처리시간 ti=70초가 지난에에 정확하게 처리부(42)에 도달하도록 적절하게 조정된다. 로보트(5)는 인덱서(1)에서 70 소~(6초×6)+22초 등안 대기해야 하고, 그 결과, 로보트(5)는 처리부(41)에서 60초의 처리가 완료된 후 *10(ti=10)초 후에 처리부(41)에 도달한다.

로보트(5)는 인역사(IND)에서 22초 동안 대기할 필요는 없다. 그러나, 제6분에 나타난 반송 수순이 다음 과 같은 한, 처리 1위에 대해 도달한 처리시간, 즉, 70초는 일순이동 속도를 결정하고, 그러므로 어느곳에 서나 22초의 대기시간을 설정하는 것이 필요하다. 지면시간은 제4도에서 점선부에 의해 나타난다. 이를 지면시간중 특히, 처리 HP.에서의 지연시간(t)은 가장 삼각한 문제를 파성시킨다. 이것은 제5도에서 이미 상숨된 바와 같이, 과열 처리는 포토레지스트의 때 던 정입성에 치명적인 악영향을 까치기 때문이다.

더우기, 복수의 웨이퍼의 로보트가 계속적으로 처리되고, 다른 처리시간이 각 로트마다 다른때에 지면시 간(t,) 그 자체가 각 로보트내에서 여러가지로 된다. 예름들면, 웨이퍼(3a,3b,3c)가 처리 HP.에서의 70초 를 요하는 로트에 포함되고 웨이퍼(3a,3e,3f,...)가 처리 HP.에서 65초를 요하는 다른 로트에 포함하는 경 우를 상정한다.

하삼표(16d)는 t3-65초 동안 처리 IP3를 받게 되도록 되어 있는 최종 로트내에서의 제1웨이퍼인 웨이퍼 (3d)에 향하지는 처리의 호통을 나타낸 것이다. 65초동안 웨이퍼(3d)상에서 처리 IP3를 향하기 위해서, 인택시(1)의 로보트(5)의 대기시간은 최장 대기시간, 즉 22초 보다 짧은 5초(70초-65초)가 된다. 그것은 처리부(4)로 이동하기건에 17초동안 인택시(1)에서 로보트(5)가 대기하기 때문이다. 그러므로, 로보트(5)가 도착한다. 가기를 대지막으로 떠난 호 65초 호에 웨이퍼(30)를 제내가 위해 처리부(41)로 로보트(5)가 도착한다. 처리 IP3에서 지연시간은 70-65-5초만큼 처리 IP3에서의 감소에 따라 5초(t, 7)만큼 바로 감소하게 된다. 지연시간 t, 에서 지연시간 t, 로 감소는 웨이퍼(3b)와 같은 로트에 속한 웨이퍼 체인(3d,3a,3f,3a,···)중웨미퍼(3a)에 뒤따르는 웨미퍼에만 영향을 준다. 웨미퍼(3d,3a,3f)는 지연시간(t,)의 감소가 알머나게 말 때 처리 IP3에서 이미 처리되어서 지연시간의 감소는 웨이퍼(3d,3a,3f)에 대한 처리 IP3에 영향을 주지 않는다.

그 경과 웨이퍼(34,3e,34)는 다른 웨이퍼(3e,…)와 다른 온도 커브를 통하여 가열 처리 IP,를 받게 된다. 제1 및 제2로트가 제공되고 각 로트마다 25세의 웨이퍼가 포함되는 경우에서 제2로트내의 선행하는 3개 웨이퍼는 나대지 22세의 웨이퍼 보다 긴 시간에 가염처리를 받게 된다. 그 경과, 한계 노광량 등과 같은 중요제어(관리) 피라미터가 각 로트내에서 판차를 가지며 그 경과 선각한 문제가 이가된다. 또한, 로운 문제점이 제1로트에서도 발생한다. 제1로트 이전에 아무런 로트가 존재하지 않기 때문에 제1로트내의 선행 3개 웨이퍼가 순차적으로 처리 IP,를 받는 동안에 처리 IP, 및 CP,가 이직 시작되지 않는다. 그래서,이 시조기간에서 처리 IP, 및 CP,가 완전한 것이에서, 순환처리의 속도는 처리 IP,라기 보다는 처리 IP,로 서 결정된다. 따라서,로보트(5)는 소정의 시간 즉,처리부(41)에서 처리 IP,가 시작된 후 60초에 처리부(41)로 되답아온다.

처리 IP-가 처리경로로의 4번째 웨이퍼의 공급에 응답해서 시작될때, 순환처리의 속도는 70초의 가장 간춰 리시간을 요구하는 처리 IP-에 의존하게 된다. 그래서, 같은 로트에 포함된 웨이퍼중에서 단지 처음 3개 웨이퍼만이 과명 처리되지 않는다. 그러므로 이 3개의 웨이퍼는 같은 로트내에 모두 포함된다 해도 다른 22개의 웨이퍼로와는 다른 온도커브를 통하여 가열 처리를 받게 된다.

그러나, 상슬된 바람직하지 않는 사태는 다음과 같은 처리방법에 의하여 피할 수 있다.

(1) 청상상태 뿐만 아니라 과도상태에 있어서도 단일 일정 주기로 순환처리경로를 따라서 로보트(5)를 구 등하는 것과, (2) 로보트(5)가 처리부(4)로 되돌아 올때 바로 처리 바,가 중로되도록 처리 바,의 개시시 간을 시간(6) 또는 시간(6)에 상용하는 시간만큼 지면시키는 것이다.

본 발명의 실시에에 따르면, 웨이터를 따지한 로보트(5)는 처리부(41) 바로 옆에서 시간(6) 또는 시간 (6)에 하당하는 시간을 대기하도록 제어하고, 그후 처리 HP를 위해 처리부(41)으로 웨이터를 집어 넣는 다.

제7도는 본 방당의 실시에에 관한 기관 변승방법의 전체 호흡도를 LIEJ센다. 제1스탭(101)에서, 각 처리 부에서 요구되는 처리시간이 키보드(19) 등을 통해서 압력된다. 본 방영의 실시에에 따른 각 처리부의 처 리시간은 제2표와 많이 결정된다.

[**E** 2]

제1로드의 처리 HP,의 저리수같	T,=60≥
제1로트의 커리 (P,의 처리시간	7 ₅ =45±
제 1 로드와 처리 C의 처리시간	T,=50±
제1로트의 처리 HP,의 제리시간	T ₄ =71±(=t ₄)
मा द्राह्म भेग (२.अ भेगभर	T ₁ =52
제2로트의 처리 HP,의 처리시간	T ₆ =60&
제2로트의 처리 (마,의 처리시간	T,=62
제 2 또로의 처리 C의 처리시간	T _s =31±
제임로트의 제리 HP,의 처리시간	T ₁ =63±(=4)
제2도도의 처리 CP.의 체리시간	Tu=61

이를 처리부에서 각 처리시간의 각각은 피처리부대에 웨어퍼가 투입을 때부터 그곳으로 부터 웨이퍼가 제 내어절매 까지 지나는 시간에 해당한다. 그러므로, 처리시간의 각각은 웨이퍼를 깨내는 시가은 물론 투입 되는 시간(Tin)도 포함된다. 즉, 각 처리부의 위의 투입되는 시간(Tin) 및 깨내는 시간(Tout)은 제도에 나타난 비와 같이, 로보트(S)의 반송 시간의 임부분을 구성하며, 한편, 미를 시간은 각 처리부족인에 처 리시간의 임부이다. 각 처리부의 처리시간은 이를 시간(Tin, Tout)과 실점적으로 처리를 수행하기 위한 순처리시간(Tott processing time)으로 이루어진다. 애름들면, 포토레지스트-로포에 대한 처리부(B)에서의 처리시간은 상기 시간 Tin 및 Tout와 웨이퍼에 포토레지스트를 도포하는 데 소요되는 순수한 시간(ret time)으로 이루어진다.

각 처리부간의 반송시간(T')은 로보트(5)의 이동성능 및 인접처리부간의 거리를 근거하여 커보드(19)를 통하여 입력하며 놓아도 좋고, 미리 다음트(default) 값으로 하여 놓아도 좋다.

예를롭면, 8초의 값이 반송시간(T')으로 입력되고 이 값은 로보트(8)가 처리경로를 따라서 각 2개의 인접 처리부 간의 거리용 가장 큰 거리와, 인접하는 2개의 처리부대에서 웨이퍼를 교환하는데 필요한 사건의 함수로서 얻어진다.

다음 스템(102)에서, '투업 대기시간' 및 먹트시간을 나타내는 각각의 값이 업력되어서 체크된다. '투업 대기시간'은 '각 처리부로 웨이퍼를 집어넣기 위한 대기시간으로 장의된다. 먹트시간과 투업 대기시간은 상세하게 후술한다. 다음 스템(103)에서 먹트시간 및 투업 대기시간은 변승을 제어하고 처리부에서 각체 리를 수행하기 위해 사용된다.

스탭(102)을 더 자세히 기술하면, 제8도에 나타난 바와 같이, 먹트시간(To)을 지시하는 값은 스탭(104)에 서 기보드(19)급: 통하여 압력된다. 다음:스탭(105)에서, 먹트시간(To)은 로보트(5)의 순환시간(Tc)과 네 교된다. [순환시간(To)은 로보트(5)가 처리경로 혹은 처리 쿠우트를 순환하는 데 필요한 시간으로서, 다음 과 같에 계산된다.

T=cN.x-T	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.(1)

(여기자 씨은 처리부의 중수로서 표 2에 도시된 예에서는 '5'이다.

·또한, 먹트시간(TO)은 처라시간의 다른 각조에 대한 각 처리부에 발당된 처리시간 TJ(J)의 ~k,)의 각각과 - 비교되며, k는 다음식과 같이 정의된다.

N=K×N,(2)

단, i는 처리시간이 다른 조(set)의 수를 나타내는 양의 정수이다. 표 2에서 나타낸 예에서는, 처리부 N 의 수는 5이고, 처리시간이 다른 2개의 조가 있다.

처리시간(T_a,T_a,···T_a)의 제1조는 제1로트 웨이퍼용이고 처리시간(T_a,T_a,···T_a)의 제2조는 제2로트 웨이퍼용 이다. 그래서

K=2(4)

N=2×N=10(5)

가 일어진다.

택트시간(To)이 Tj(j=1~H) 및 Tc의 각 값보다 깊거나 같은 때만, 즉,
To≥Tc 및 To≥Tj(j=1~N:)
일때어만 그 다음 처리가 향하여 진다.
핵토시간이 각 처리시간 Tj과 순환시간 TcH, < T'의 합 또는 이를 각각 보다 적을 때, 처리부로 웨이퍼를 투입하기 전에 로보트(5)에 할당된 추가시간이 없기 때문에 루입 대기시간을 설정하는 것이 불가능하다. 조건(6)을 만족시키지 않는 적합치 않는 핵토시간(70)이 입력될때, 경고가 디스플레이(14)성에 표시되고, 새로운 핵토시간(10)을 나타내는 새로운 값이 입력된다. 새로운 핵토시간은 이견의 핵토시간보다 갈어야 한다. 이것은 만약 입력된 이전 핵토시간보다 새로운 핵소시간이 짧으면 조건(6)은 다시 만족하지 않기 때문이다. 조건(6)이 만족릴때까지 핵토시간의 입력은 반복되고, 조건(6)를 만족시키는 핵토시간이 일어 절대, 핵토시간(10)은 각 로트 즉, 위의 예에서 제1및 제2로트내의 모든 웨이퍼에 공통으로 설정한다.
이 먹트시간(To)은 로보트(5)가 각 처리뷔배에서 순차적으로 웨이퍼를 반송 및 교환하면서 각 처리부를 일순하는 시간을 규정하는데 쓰여진다. 먹트시간(To)은 정상적인 처리상태 및 괴도상태 모두에 공통으로 설정된다.
정상상태란 일련의 웨이퍼가 처리의 수순을 바꾸지 않고 처리경로를 따라서 처리되는 기간을 말한다.
과도 상태란 최초상태와 중로상태를 포함하는 것이다. 최초의 상태란 어느 한 로트내의 선행 웨이퍼가 처 김경로내에서 처리되고 있는 상태를 맡한다. 중로상태란 어느 한 로트내의 마지막 웨이퍼가 처리경로에 들어가는 상태를 말한다. 스텀(105)에 의하면, 다음의 조건(7)이 택트시간(To)에 작용된다.
비람작하게는, 택트시간(To)는 조건(8)에 따라 선택된다.
$I_0 \rightarrow n_0 \times (I_1, \dots, I_{n_c}, I_c)$ (8)
지금 고려되고 있는 상기 예에서, 먹트시간(To)은 다음과 같이 결정된다.
T_0 = \mathbf{n} $\times (T_1, \cdots, T_{n2}, T_0)$
$= \max \times (T_{s_1}, \dots, T_{s_{2^{s_1}}}, H_{s_1} \times T')$
=t,
=t, 70초(9)
70초

m=1~KOI立, j=1,2,···凡公田, $T_n \geq U_m = T_n + S_n$ -----(14) $T_a \geq V_1 = T_1 + T_{a_1}$ 상기 식 전체가 만족되는가 아닌가를 관정한다. 상기 조건(14)는 스템(106)에서 거습된 것과 독립은 이유 때문에 필요하게 된다. 그러나, 스템(107)에서 조건(14)은 스템(105)에서 조건(6)보다 알격하다. 왜나하면, 식(14)의 오른편에는 값 Tc를 추가해서 조건 T,≥0음 만족시키는 값(T,)의 합계(\$m)음 포함하기 때문이다. 조건(14,15)여 만족되지 않을때, Twi에 대한 새로운 값이 압력되고, 이 처리는 상기 조건(14,15)을 만족 시키는 Twi의 값이 발견될 때까지 반복한다. 대기시간 T.C은 T.=U.=T.+S..... T,=V;=T,+T,---을 만족하도록 결정되는 것이 바람직하다. 지금, 고려되고 있는 실시에에서, 아래의 석(18)~(21)에서 지시되는 1.의 값이 압력되어 있다. 석(18) 내지 식(21)에서의 TeJ의 값은 스텝(107)에서 요구되는 조건(14,15)을 만족시키는 것이 쉽게 확인된다. $\underline{I}^{ab} = \underline{I}^a - \underline{I}^b = \underline{105} \text{ and in the interpretation of the property of the pro$ T==T0-T,=1,=52 -----T=02(j+169)----한판, 모든 처리부의 처리시간 T.(j=i,2,···N) 및 순환시간(T.+N,+T')층에서 가장 건 것이 최대시간(Tmox) 으로 선택된다. 그때 택트시간(Ta)는 조건 를 만족시키도록 선택된다. 로보트(5)가 웨이퍼를 켜내기 위해 대기해야 하는 처리부가 있을때, 본 발명의 조건이 만족할 수 있도록 이끌 처리부의 각각에 대하여 대기시간이 $\mathsf{T}_{\mathbf{x}} = \mathsf{T}_{\mathbf{x}} - \mathsf{T}_{\mathbf{x}} + \mathsf{T}_{\mathbf{x}} +$ 으로 설정된다. 스텝(102)에서의 순환은 콘트롤러(15)에 의해 행해진다. 비흡적하기는 유한 값은 먼저 가열 처리부에 대한 대기시간(TG)에만 주어진다. 식(20.21)은 비합적한 경 우에 하당된다. 제7도에 도시된 스텝(103)의 상세한 내용은 제9도를 참조하여 설명한다. 제9도에서 상불 1는 1번째 처리 부을 나타내고, 연덕시(1)는 이를 처리부중 하나이다. 바람작한 살시에에 따르면 1와 각 처리와의 대응은 다음과 같다. 1=1+6n 인덱사(1) j=2+6n 기열 처리부(41) (처리 HP.) 1=3+6n 냉각처리부(43) (처리 CP₁) i=4-6n 도포 처리부(13) (처리 C) I=5·6n 기열 처리부(42) (처리 HP.) .i=6(m·1) 냉각 처리부(44) (처리 CP:) 단, n은 0 또는 지연수이다. 스템(108)에서 도시된 심별 a는 로보트(5)가 어느 순간에서 위치하는 처리부를 나타내고 a와 각 처리부 시미의 대응은 i와 각 처리부 사이의 대용과 같다.

스턴(109)에서, 수 α시는 그 순간에 빠치된 로보트(5)가 위치하는 처리부 다음의 처리부를 나타내기 위한 사료은 α의 값으로 주어진다. 스텀(110)에서, 처리부(α)로 로보트(5)를 움직임 필요였는가 없는가를 판정한다. 여름들면, 제1翰이퍼가 처리 바?등 위해 처리부(4)에 투입된 후, 처리 다?를 위해 처리부(43)로 로로브트(5)를 이동할 필요가 없을 때에는 처리는 중로 루우틴(111)으로 진행되고, 이에 대하여서는 후율하다.

α-번째 처리를 위해 처리부로 웨이퍼를 반응할 필요가 있을때, 로보트(5)는 α-번째 처리부로 움직이고 (스텝112), 번호 i는 스텝(113)에서 번호 α에 의해 정의된다.

스템(114)에서, 역트 EIOI대(SI)는 I-번째 처리부에 대용하여 설정된 EIOI대이고 먹트시간(T₆)는 먹트EIOI대(SI)에서 설정된다. 스템(114)에서, 택트EIOI대(SI)가 시간이 다짐때 파지, I-번째 처리부의 앞의 위치에서 로보트(5)가 대기한다. 스템(115)에서, 택트EIOI대(SI)는 리세트되고, 택트시간(T₆)이 지나서 택트타이대(SI)가 다 함때 다시 시작한다. EIOI대(SI)의 EIOI대(BI)에 응답해서 I번째 처리부에서의 처리가 시작된다. 에서 T₆까지의 시간계수가 EIOI대(SI)에서 반복되어서, I-번째 처리부에서의 처리는 택트시간(T₆)의 가격으로 반복된다.

복잡성을 피하기 위해서, 제1웨이퍼가 처리되는 경우에서의 핵토단이데(SI)의 작동은 제9도에 도시되어 있지 않다. 이 경우, 인역서(1)용 핵토단이머(SI)는 즉시 종결되고, 웨이퍼는 즉시 처리 IPI를 위해 처리 부(4)로 반송된다. 다음의 처리부를 위한 핵토단이머는 이를 처리부용 스럽(115)이 아직 수행되어 있지 않기 때문에 핵토시간(I)를 카운트할 수 없게 된다. 그러므로, 이 핵토단이머 상태는 로보트(5)가 이전 처리부로 부터 웨이퍼을 깨낸 후 대기시간 및 반송시간이 종료될 때 초기상태의 이를 핵토단이머가 종결 되도록 설계되어 있다.

스템(116)에서, [번째 처리부에서 이미 웨이퍼가 존재하고 있다면, 이 웨이퍼는 꺼내어진다. 스템(118)에서, 에이퍼의 무입을 위한 대기 시간이 현재의 처리부에 대하며 설정되며 있는지를 관정한다. 만약 설정되어 있으면, 로보트(5)는 스템(110)에서 웨이퍼를 끄겁어내게 위해 대개하는 동안에 [번째 처리부의 앞에서 대기시간을 보낸다. 그리고나서, 스템(120)에서 로보트(5)는 [번째 처리부에서 웨이퍼를 꺼낸다. 상습한 처리를 반복할으로서, 처리경로에 따른 웨이퍼의 반송은 먹트시간(1.) 및 대기시간(1..)를 사용함으로써 제어된다.

종료 추우된(111)은 어떤 처리부에서도 그 이상 수행되어야 할 처리가 없는 경우에서 반송을 종료시키기, 위해 설정된다. 종료 투우탄(111)에서 로보트(6)가 처리부로 더 이동할 필요가 있는가 없는가를 판정한다. 이 판정은 로보트(5)의 현재위치에 뒤 미르는 각 처리부에 대하여 하나씩 실행되게 된다. 시스 혐의 등적은 파라메타(L)가 '주이 필 때 중로되고, 그것은 더 이상 실행해야할 처리가 날아있지 많다는 것을 나타낸다. 상송한 등작 흐름으로 처리 바에서 과잉 업처리가 화피함 수 있다.

어떻게 과영 얼처리가 회피되는가는 제124도를 참조하여 설명하면, 웨이퍼(34~3h)의 흐름은 화상표(164 ~-16h)에 의해 각각 나타난다.

로보트(5)가 인력서(1)(a-1)로 부터 웨이퍼(3)을 꺼낸 후, 로보트(5)는 스템(108,110,112)에서 처리부 (41)(a-2)로 이동한다: 현재위치(1-2)는 스템(113)에서 기억된다. 로보트(5)가 처리부(41)에 도착했음때 처리부(41)에 대한 먹트타이머(\$)가 타임업된다.

그러므로, 티이마는 리세트되어 다시 시작한다(스템 114 및 115).

처리부(41)네에 있는 웨이퍼(39)에 대한 처리가 중립되기 때문에 게이퍼(3e)는 끄겁이 내어진다. 그러므로, 스텝(116)에서, 웨이퍼(3e)는 제124도에 표시한 시간(A)에서 처리부(41)로 부터 꺼내어진다.

증해의 반응병법에 따르면, 웨이퍼(해)는 즉시 처리부(세)로 투입된다. 이에 대하여, 본 발명의 실시예에 따르면, 처리부(세)과 제외대를 급여내고기(투입하기) 위한 대기시간(185개 설정된다. 특히, 스턴(18)에서 처리 바,를 위해 처리부(세)에 대기시간이 설정되어 있음을 알 수 있다. 그때, 로부트(5)는 처 다-(70-60)초-10초에 해당하는 시간동안 웨이퍼를 제내가 위해 스턴(19)에서 대기한다. 시간(다)가 제1초도에 나된단 시간(8) 지방 때, 스턴(19)에서 웨이퍼(81)는 처리부(세)로 투합된다.

그러므로, 시간(A)에서 시간(B)까지 즉 대가시간(18A) 동안에는 처리부(41)에 웨이퍼가 존재하지 않게된 다.

반송시간은 시간(B)에 시작하다 시간(A)에 끝난다. 그러므로, 제5도에 나타난 반송시간의 정의가 적용 될 수 있다. 스텀(109) 및 다른 스텀을 통해서 로보트(5)는 처리 CP,를 이해 처리부(43)로 웨이퍼(3e)를 반송 한다.

그래서, 순환숙도약 제한에 의한 웨이퍼상의 과잉가렴은 가열부 앞에서 대기시간을 실정함과 동시에 공통 택트시간(T.)를 설정함으로써 따할 수 있다.

더욱 정확하게 말하면, 스템(116)에서 처리부로 부터의 웨이퍼를 깨낼 형요가 없을 때, 로보트(5)는 꺼내는 시간(Took)동안 기다리게 되고, 반면에 스템(120)에서 처리부로 웨이퍼를 투입할 필요가 없을 때는 로 보트(5)가 투입시간(Tin)동안 기다리다.

웨이버(36)는 웨이버(36~36)를 포함하는 제2로트있는 다른 제1로트에 속하고, 웨이버(36~36)와는 다른 시간 동안에 처리 바로 발개 되어 있다. 제1로트에 속한 웨이퍼(36) 및 다른 각 웨이퍼는 제2로트에 대한 처리 바의 시간보다 다른 지구, 구5초 만큼 더 짧은 시간 동안 처리 바일 받아야 한다. 왜나라면, 렉트시 2(T₆)은 각 로트에 공동으로 설정되고, t₂-5초의 대기시간(185)은 웨이퍼(30)에 대하여 설정되어 있기 때 문이다. 처리 바로를 발개된 웨이퍼(36)는 시간(A)에서 처리부(42)로 부터 꺼내지고, 웨이퍼(36)는 시간 (B)에 루입된다.

상습한 바와 같이, 공통 핵트시간(T_e)은 복수의 로트에 대하여 성정되고, 대기시간(18a, 18b)은 핵트시간 (T_e)의 합수로서 성정되어 있기 때문에, 각 웨이퍼에 대한 과잉 가영처리가 회피될 수 있다. 또한, 각 웨 이퍼는 제15도에 나타난 이상적인 온도곡선에 근접하는 온도곡선에 따라 처리되고, 각 로트간의 열이력의 병임처음 회피할 수 있다.

상술된 실시에에 따르면, 눈땀요한 부가적인 가열처리가 일어나지 않도록 각 처리는 그 자신의 이상적인 처리 시간동안안 실행된다. 그러므로 서로 다른 처리 시간을 가지는 복수의 로트가 계속적으로 처리됩때 도 각 로트에서 웨이퍼 사이에서 온도 곡선이 변하지는 않는다. 즉 동일 로보트내에서 다른 열이력을 가 진 웨이퍼가 생기지 않는다.

전 제이에가 장가지 않는다.
제2도로에 대하여 핵토시간이 또한 70초로 설정되면, 생산성이 떨어지는 것같이 생각할 수 있으나, 다음 의 예로 부터 이해릴 수 있는 바와 같이 사실이 아니다. 즉, 다른 핵토시간이 제1 및 제2로트에 대하여 설정된 경우에 대하여 가정하면, 예를 들면, 제1 및 제2로트의 각 25개의 웨이퍼에 대하여 70초 및 25초의 핵토시간이 각각 설정되고, 65초의 후자의 핵토시간이 제로토내의 25개 웨이퍼 전부 각 처리본에서 처리된 후에만 유효한 것으로 가장한다. 이 경우에 있어서, 시스템의 핵소시간은 제1로트의 마지막 4개 웨이퍼 즉, 22번째에서 25번째 웨이퍼가 70초의 핵토시간으로 처리를 받은 후에나 70초에서 65초로 변경된다. 이것은 70초×4=280초가 낭비되는 것을 의대한다.

한편, 상습한 본 발명의 실시에에 따르면, 제2로트상에 대한 처리동안에 대기하는데 남비되는 낭비시간은 단지(70-65초)×25=125초이다.

그러므로, 본 방당의 일실시에에서는 각 로트륨 독립적으로 처리하는 경우보다 낭비시간을 적게하고 생산 성출 높열 수 있게 된다.

실시에에 따른 상습한 처리에 의하면 포토레지스트의 현재노출량의 변동이 크게 감소된다. 일본 가나가와 가와사끼 소재의 도오교오 오카 공업사의 생산중 ISAR-6900이 3800rpm의 회전에서 실리폰 웨이퍼를 도포 하기 위해 사용된다.

그리고, 처리된 웨이퍼는 이래의 조건 이래서 현상된다.

현상제: NMD-32.38X(토오쿄오 오카 공업사에서 구입가능)

현상시간 : 60초 현상제의 온도 : 23°C 물세척 : 15초 건조 : 15초

상기 헌상 조건하에서의 레지스터 도포처리에 있다서, 한계노랑량은 본 발명의 실시에에서 방법으로는 Sal 이하의 범위에서 변화하는 반면에 기관을 도포하는 중래의 방법으로는 20a의 범위에서 변화한다.

상기 설명된 실시에에 따른 대기시간(18m,18b)을 보고나서 명박하게 이해할 수 있는 바와 같이, 대기시간 은 단일 가장처리부가 설치되어 있는 것으로만 제한되지 않는다. 어떤 경우에 있어서는 복수의 가압처리 부율 성치하여도 된다. 그러한 경우는 본 발명의 또 다른 상시에로서 어래와 같이 심시된다.

표 3에서 나타난 처리시간(T,, \sim T, $_{*}$)이 하나의 로트에 적용할때, 처리경로에서의 $^{\circ}$ 처리속도는 처리(C)의 처리시간(90초)으로 결정된다.

[# 3]

भव भार,	Tu=70±
위화 CP,	T _m =50.k
계리 C	Tu=902
श्रेम HP,	T _M =804:
₩¢ HP.	T _m =50. <u>4</u>

스템(107)에서 요구된 조건을 만족시키기 위해서, 먹트시간(16)은 적어도 90초이어야 한다.

따라서, 예로서, 렉트시간(To)은 Ta=90초로 설정된다. 처리 OP, 및 OP는 냉각처리하므로, 제5도(b)에 나타 난 과양 기업 문제품 고려할 필요가 없다. 따라서 대기시간 Ta=Ta=Ta=10초가 처리 HP,앞에 설정되고 반면 에 대기시간 Ta=Ta=Ta=20초가 처리 HP,앞에 설정된다. 따라서 처리(HPa,HPa)동안에 과열문제가 최피를 수 있다.

모든 처리부음 통하여 웨이퍼를 반송하기 위해 요구되는 충반송 시간은 48초이고, 먹트시간(T,)과 총 반송 시간과의 처에는 42초이다. 대기시간(T,, T,,)의 함은 30초이고, 상기 처미인 42초보다 12초 작다. 로보트 (S)는 투입을 위하여 대기시간보다 다른 12초등안 대기하여야 한다. 로보트(S)는 어느 위치에서 이 추가 시간 동안 기다려도 된다. 제12도는 인택서(1)에서 이 추가시간 동안 대기하는 로보트(S)에 예를 나타낸 다. 각 웨이퍼상에 실행되는 처리의 흐름을 나타내는 화삼표(6)상에, 시간주기(18c.18d)는 각각 대기시간 (T.,,,T.)을 나타낸다.

대기시간은 제9도에서 도시한 제어와는 다른 제어하에서 설정할 수도 있다. 제10도에 나타난 바와 같아. 예술물만, 각처리부가 각각의 백트타이대를 제어하는 동안 인역사(1)은 전체의 백트타이대를 제어하여도 된다. 특히, 스탭(121,114a)에서 안역사(1)로 부터 로보트(5)의 하나의 활발시간과 다음 출발시간 사이의 간격을 백트시간(16)으로 설정하고 마스터 백트타이대(6, 1월 스탤(1184)에서 시작하는 것이다. 여와적으로, 세1翰이대가 투입함때 마스터 타이대는 즉시 스탤(114a)에서 중로된다.

핵트시간은 제11도에 나타난 바와 같이, 인택서(1)에서만 제어될 수 있다. 이 경우에, 2개 처리부 사이의 로보트(5)의 각 어롱시간(Teove)은 이동타이머(N)(스랩 123)에 의해 제어된다.

가열처리를 받지 않는 로트가 있을때, 그 로트에 대한 대기시간(Tu)은 이래 조건에 따라 결정될 수 있다.

혹은, (m-1)N,-1 ≤ j ≤m.N,에 대하면 T,,=0(25)

단, 숫자 🗝 로트를 나타낸다.

본 밝명은 자시하고 분명하게 기술되었으나 이는 설명과 여제일뿐 본 발명을 한평하고자 한 것은 아니다. 본 말명은 기술사상과 범위는 첨부된 청구범위에 의해서만 재한된다. 따라서 본원발명의 범위를 벗어남이 없이 여러가지의 수정이나 변경이 있을 수 있다.

(57) 원구의 범위

성구합 1

반도체 기관에 소정의 처리를 심현하기 위하고, 성기 반도체 기관에 열을 가하는 적어도 하나의 가열 처리부를 가지는 제1~재번째 처리부(은, N는 1보다) 큰 정수)를 구대하는 시스템에서, 성기 반도체 기관에 상기 제1~재번째 처리부를 순관하는 처리 공료를 따라서 반송되고, 반송수단으로 순처적으로 반도체 기관에 상기 제1~재번째 처리부를 순관하는 처리 공료를 따라서 반송되고, 반송수단으로 순처적으로 반도체 기관을 받송하는 범행에 있어섯, (e) 제1~재번째의 처리부에 공통인 단입학트시간(*,)과 1·5)로써를 만약시 커는 각 수 (에 대하여 대기시간 T.을 포함하는 파라메터 값을 결정하는 스템과, (b) 상기 반송수단이 상기 처리경로를 따라서 반복적으로 순환하고, 상기 반도체 기관의 현업에 제1~번째 처리부를 경우하여 상기 처리 경로를 따라서 발목적으로 순환하고, 상기 반도체 기관의 한법에 제1~번째 처리부를 경우하여 상기 처리 경로를 따라서 알로드록 상기 반송수단으로 상기 제1~번째 처리부로 삼기 반도체 기관을 순처적으로 반송하는 스템을 구내하고, 또한, 상기 반도체 기관을 순처적으로 반송하는 스템을, (b-1)번째 처리부로 나타에는 상태를 구하는 스템과, (b-2) 상기 반송수단으로 (j-1)번째, (j)번째 처리부로 반도체 기관(S,-1)를 개세고 나서 상기 학문시간(T,)이 자살에 까지 (j)번째 처리부 앞에서 대기하는 스템과, (b-4) 상기 핵도시간(T,)이 지상에 바지 (j)번째 처리부 앞에서 대기하는 스템과, (b-4) 상기 핵도시간(T,)이 지상에 가진(S,-1)를 가면(S,-1)를 (j)번째 처리부로 부터 반도체 기관(S,-1)를 내기하는 스템과, (b-5) 상기 대기시간 T.를 대기하는 스템과, (b-6) 상기 대기시간 T.를 대기하는 스템과, (b-6) 상기 대기시간 T.를 대기하는 스템과, (b-1) 상기 반송수단으로 반도체 기관(S,-1)를 (j)번째 처리부로 부터 반도체 기관(S,-1)를 (j)번째 처리부로 가진(S,-1)를 (j)번째 처리부로 무대하대, j-12에 대하여 (j-2)번째 처리부로 가진 상기 반송수단으로 반도체 기관의 반송생합.

청구함 2

제항에 있어서, 상기 스템(a)는, (a-1)(s)로써를 만족하는 각 수 j에 대하여, (j)번째 처리에서 상기 반도체 기관이 얼마동안 처리받는지를 나타내는 처리시간(T,)을 결정하는 스템과, (a-2) (s)로써 만족하는 각 수 j에 대하여 아래의 제1조간(1)

를 만족시키도록 상기 먹트시간(To)를 결정하는 스템을 구비한 반도체 기관의 반송방법:

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 스텝(a)는, (a-3) 상기 반송수단이 상기 처리경통로를 순환하는데 최소시간으로 되는 반송시간(T_a)을 결정하는 스텝과, (a-4) 상기 반송수단이 상기 처리경통로를 순환하는데 최소시간으로 되는 반송시간(T_a)를 결정하는 스텝과, (a-4) 상기 제1조건은 물론 아래의 제2조건(II)

 $T_{\mathbf{a}} \succeq T_{\mathbf{c}} : \dots : \sigma_{\mathbf{c}} : \dots : \sigma_{\mathbf{c}}$

을 만족시키도록 상기 먹트시간(%)를 결정하는 스템을 더 구비한 반도체 기관의 반승방법.

多구한 4

제3항에 있어서, 상기 반도체 기관은 복수의 로트로 분류되고: 상기 스텝(a)는, (a-5) 상기 제1 및 제2 조건은 물론 이래의 제3조건(III)

T,≥T, +Su(III)

단, 값 Sa은 다음식(E1)에 의해 정의되고,

$$Sm = \sum_{j=m-1, N_j \sim 1}^{m, N_j} T_{w_j} \cdots (E1)$$

수 많은 상기 반도체 기판의 관재로트를 지시하는 양수.

을 만족시기키 위한 상기 대기시간 T.를 결정하는 스탭을 더 구배한 반도체 기관의 반송방법.

제4항에 있어서, 상기 스텝(a-5)은, (a-5-1) 상기 제1 내지 제3조건은 물론 미래의 제4조건(iv)

I,≥I,+I,(IV)

을 만족하도록 상기 대기시간 T.을 결정하는 스텝으로 더 구비한 반도체 기관의 반승방법.

결정되고, 상기 스텝(a-5-1)은, 다음식(E2)

단, 기호 bax는 T. T. …Tie T.의 각 값중에서 최대값,

에 의해 상기 먹트시간 T.를 결정하는 스텝을 더 구비한 반도체 기관의 반송방법.

제6일에 있어서, 상기 스템(a-5)는, (a-5-2) 상기 가열 처리부에 대하여서만 상기 대기시간(Tu)이 0이 아 난 값으로 설정하는 스텝을 다 구비한 반도체 기관의 반송방법.

제7항에 있어서, 상기 스템(b)는 (b·9) 상기 반송수단이 스테이손에서 최종으로 활발하고 난 후 먹트시간 (TJ)이 지말에 까지 상기 스테이손에서 대기하는 스템을 더 구비한 반도차 기관의 반송방법.

장보험 기관에 소장의 처리를 삼합하기 위한 제1 내지 반변화 처리부를 가지는 시스템에서 순자적으로 반 도체 기관에 소장의 처리를 삼합하기 위한 제1 내지 반변화 처리부를 상기 반도체 기관을 가입하기 위한 적어도 한의 가을 처리부를 가지고 상기 반도체 기관은 상기 제1 내지 바(다. N은 1보다 큰 정수)번째 처 리부를 순환하는 처리 경로를 따라서 반송자도록 한 반도체 기관의 반송장치에 있어서 (4) 상기 처리를 로릴 따라서 반도체 기관을 반송하기 위한 반송수단과, (b) 변화 내지 반변화 처리부에 공통인 단양 먹트 시간(C)과 13 1차를 만족시키는 각 반호(J)에 대하여요. 내기시간 1.6을 확실하는 때라에는 강을 유지하기 위한 수단과, (c) 상기 반송수단에 반복적으로 상기 처리 경로를 따라서 순환하고 삼가 반도체 기관의 흐 등이 삼기 제1 내지 반변화 처리부를 공유하여 상기 처리경로를 따라서 호르도록 제1 내지 반변화 처리부에 보려보여 공유하여 상기 반당체 기관을 순처적으로 반송하기 위하여 순차적으로 반송하기 위한 이상에 상기 반송하여 서기 반조체 기관이 한 건강에 제어신호 클 건당하여 성기 파라메터같의 함수로서 제어산호를 생성하기 위한 제대 수단을 구내하며, 상기 제대수 만(C)는 (c-1)(1-2)번째, (j-1)번째 및 (j)번째 처리부로 부터 나온 반도체 기관(6-1.5.5.+1)이 각각 (j-1)번째 처리부명 부터 (j)번째 처리부로 보도체 기관(5-1)을 반송하도록 위하여 성기 반송수단을 제대하 기 위한 수단과, (c-3) 상기 반송수단에 (j)번째 처리부로 부터 반도체 기관(5,1)를 제대되나서 상기 먹 기 위한 수단과 (c-3) 상기 반송수단이 (j)번째 처리부로 부터 반도체 기관(S,,)을 꺼내고나서 상기 택 트시간(T,)이 경과함 때까지 (i)번째 처리부 앞에서 대기하도록 상기 반송수단을 제어하기 위한 수단과, (c-4) 상기 텍트시간(T,)이 경과함 때 (i)번째 처리부로 부터 반도체 기관(S)를 꺼내도록 상기 반송수단 을 제어하기 위한 수단과, (c-5) 상기 대기시간 T,동안 대기하도록 상기 반송수단을 제어하기 위한 수단 과, (c-6) 상기 대기시간 T.가 경과할 때 (1)번째 처리부르 상기 반도체 기관 S.-1을 투입하도록 상기 반 승수단을 제어하기 위한 수단, (c-7) 반도체 기관 S을 (J+1) 번째로 반승하도록 상기 반승수단을 제어하 기 위한 수단과, (c-8) J-1,2; 사에 대하여, 수단(c-1) 내지 (c-7) 을 순차적으로 반복하게 하는 수단을 구비하며, J-1,2에 대하여 (J-2)번째 처리부와, J-1에 대하여, (J-1)번째 처리부와, J-4에 대하여, (J-1)번째 처리부는, 각각 상기 처리부에 상기 반도체 기판을 공급하고 처리된 기판을 받은 스테이션인 반도

체 기판의 반송장치. 청구항 10 제效에 있어서, 상기 수단(b)는, (b-l) l =j <hê 만족하는 각 번호에 대해 J번째 처리부에서 반도체 기관이 얼마동안 처리받는지를 나타내는 처리시간 다음 유지하기 위한 수단과, (b-2) 이래의 l =j <hê 만족하는 각 번호 j에 대하여 아래의 다음의 제1조건(l) 이 만족될 때에만 상기 먹트시간(To)을 받아드리기 위한 수단을 구배하는 반도체 기판의 반승장치. 제10할에 있어서, 상기 수단(b)는, (b-3) 상기 반송수단이 상가 처리경로를 순환하는데 최소시간이 되게 반송시간(f,)을 유지하기 위한 수단과 ; (b-4) 상기 제1조건은 물론 다음의 제2조건(ii) T₀≥Tc(II) 이 만족할때 상기 먹트시간(To)를 받아 드리기 위한 수단을 더 구비한 반도체 기관의 반송잠치. 제11항에 있어서, 상기 반도체 기관은 복수의 로트로 분류되고, 상기 수단(b)는 (b-5) 상기 제1 및 제2조건은 물론 아래의 제3조건(III) I,≥ I,+Sm.... (111) 단, 값 Si은 다음식 (EI)에 의해 정의되고, (E1) 수 🕪 상기 반도체 기판의 번째 로트를 지시하는 영약 수. 가 만족할때 생기 대기시간 T.aa 받아드러기 위한 수단을 더 구비한 반도체 기판의 반송장치. 제12항에 있어서, 상기 수단(b)는, (b-6) 상기 제1 내지 제3조건은 물론 이래의 제4조건(IV) 단, J=1,2.··N. 이 만족필때만 상기 대기시간 T.A을 받아드리거 위한 수단을 더 구비한 반도책 기관의 반승장치. 제13일에 있어서, 삼기 복수의 로트는 반도체 기관의 K로트(단, K는 1보다 큰 양수)를 포함하고, j=1,2; - N대하여, 상이한 조(set)의 처리시간 11가 TuTo- Tu(단, N-K,M)를 얻도록 상가 반도체 기관의 상기 K 로트에 대하여 결정되고, 상기 수단(b-6)는 : (b-6-1) 이래의 삭(만) T_s=nex(T_s, T_s, ...T_{res}, T_s)......(E2). 단, 기호 max는 T, T, ... T, 다, T,의 감사이중에서 최대값, 에 따라 결정되는 상기 먹트시간(Ta)출 받아드리가 위한 수단을 더 구네한 반도체 기관의 반승장치. ·제4항에 있어서, 상기 수단(b)는, (b-8)·상기 가열 처리부에서만:00(이년·값의 마기시간/Tg를 받아드리 기 수단을 더 구네한 반도체 기관의 반승장치. 제15항에 있어서, 상기 수단(b)는, (b-9) 상기 먹트시간(T_c)에 시행값(trial value)를 입력하기 위한 수단 를 더 구네하고, 삼기 수단(b-2)는, (b-2-1) 삼기 맥트시간(T,)에 대한 삼기 시혈결과 삼기 처리 시간 T,T, T, Te를 비교하기 위한 수단과, 삼기 (b-2-2) 조건(I)가 만족함때 삼기 맥트시간(T,)에 대한 삼기 시혈값을 사용하기 위한 수단과, 삼기 (b-2-3) 조건 (I)가 만족되지 않을때 삼기 맥트시간(T,)에 대한 또

25-14

하나의 다른 시행값을 입력하기 위한 수단을 구비한 반도체 기관 반승장치.

원구한 17

제16항에 있어서, 상기 수단(b-4)는, (b-4-1) 상기 핵트시간(T₆)에 대한 상기 시행값과 상기 반승시간(T₆)을 비교하기 위한 수단과, (b-4-2) 상기조건(1)은 종론 조건(II)가 만족필때 상기 택트시간(T₆)에 대한 상기 시행값을 사용하기 위한 수단과; (b-4-3) 상기 조건(II)가 만족되지 않을때 상기 택트시간(T₆)에 대한 또하나의 다른 시행값을 압력하기 위한 수단을 구비한 반도체 기관의 반승장치.

청구한

제17항에 있어서, 상기 수단(b)는; (b-9) 상기 대기시간(T, T, ····T_e)에 대해 각 시핵값을 입력하기 위한 수단을 더 구비하고, 상기 수단(b-5)는; (b-5-1) 상기 대기시간(T, T, ····T_e)에 대한 상기 각 시핵값과 상기 반송시간 (T₆)의 함계를 상기 력트시간(T₆)고 비교하기 위한 수단과, (b-5-2) 상기 조건(m)이 만족할 때, 상기 대기시간(T, T, ····, T_e)으로서 상기 대기시간(T, T₅, ····, T_e)에 대해 다른 각각의 시핵값을 입력하기 위한 수단과, (b-5-3) 상기 조건(m)이 만족되지 않을때 상기 대기시간(T, T₅, ····T_e)에 대해 다른 각각의 시핵값을 입력하기 위한 수단을 구비한 반도체 기관의 반송장치.

성구항 19

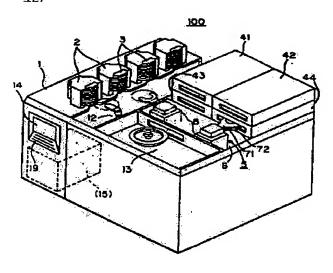
제19할에 있어서, 상기 수단, (b-6)은 (b-6-1) 상기 처리시간(T,)과 상기 대기시간(T,T,···Tw)에 대한 시 행강의 각각의 함을 상기 먹트시간(To)과 비교하기 위한 수단과, (b-6-2) 상기 조건(IV)가 만족될때 상기 대기시간(T,T,···Tw)으로서 상기 대기시간(T,T,···Tw)에 대한 상기 각 시행값을 사용하기 위한 수단과, (b-6-3) 삼기 조건(IV)에 맞지 않을때 상기 대기시간(T,T,···Tw)에 대한 또 다른 각 시행값을 압력하기 위한 수단을 구비한 반도체 기관의 반송장치.

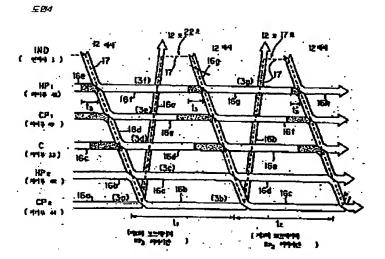
성구항 20

제19항에 있어서, 상기 수단(c)는. (c-9) 상기 반승수단이 상기 스테이손을 최종으로 출발하고 나서 상기 먹트시간(f_e)이 경과할 때까지 상기 스테이손에서 대기하기 위해여 상기 반송수단을 제어하는 수단을 더 구네한 반도체 기관의 반송장치.

도말

SE1

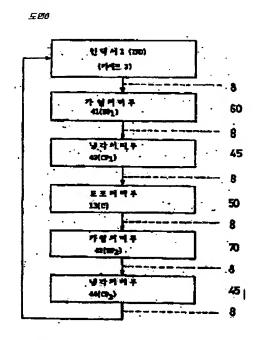


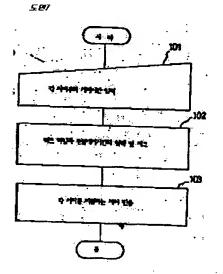


Pt क्षेत्र मिल हम एक्ष्मर Pt-1 P1 P1→P1+1 P1+1 P1+2

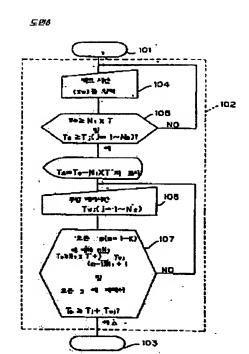
Tout Fin Touve Tout Th

क्षात्र) व्यवस्था क्षेत्र क्या क्षेत्र क्षेत्



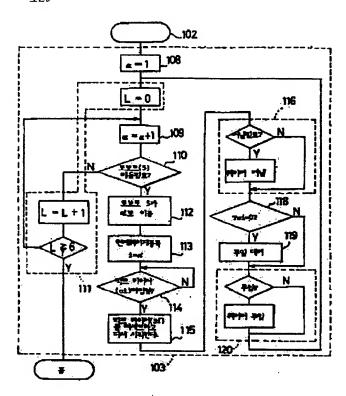


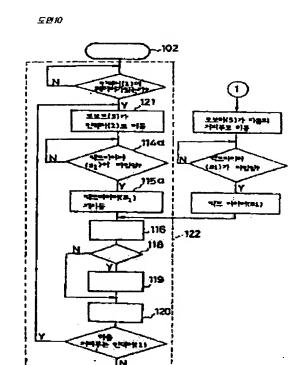
25-18



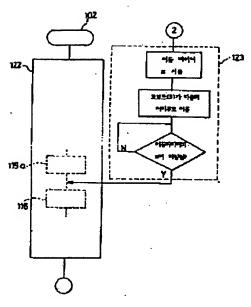
与1995-0008844

⊊89

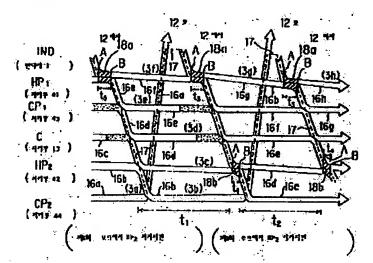






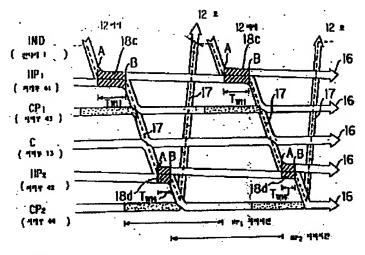


*도만13*1

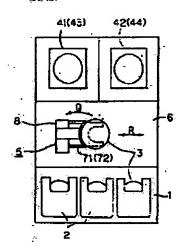


25-22





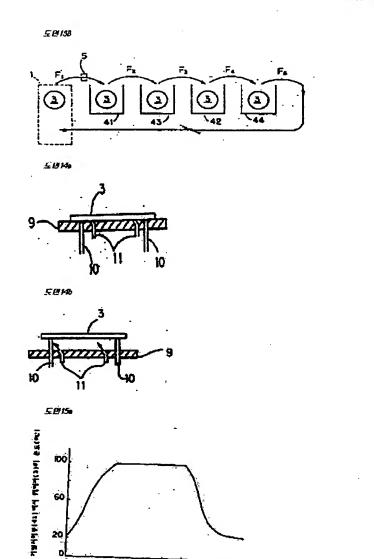
⊊*013*(



25-23

60

20



नेश्वमक्तिको व अनुन्धिक स्थाप क् क्षम वस्ति





